

# 2SJ317

シリコンPチャネルMOSFET  
電力増幅・スイッチング用

# HITACHI

## 特 長

- 低オン抵抗  
 $R_{DS(on)} = 0.28\Omega$ 標準  
@ $V_{GS} = -4V$ ,  $I_D = -1A$
- 電流容量が大きい  
 $I_D(\text{pulse}) = \pm 4A$

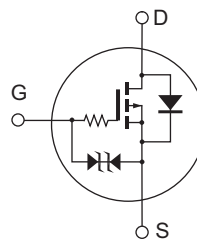
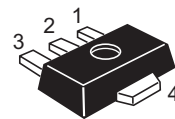
## 絶対最大定格

( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

項目	記号	定格値	単位
ドレイン・ソース電圧	$V_{DS}$	-12	V
ゲート・ソース電圧	$V_{GS}$	$\pm 7$	V
ドレイン電流	$I_D$	$\pm 2$	A
せん頭ドレイン電流	$I_D$ (pulse)*1	$\pm 4$	A
許容チャネル損失	$P_{ch}$ *2	1	W
チャネル温度	$T_{ch}$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55~+150	$^\circ\text{C}$

- 注) 1. パルス幅  $\leq 100 \mu\text{s}$ , デューティサイクル  $\leq 10\%$   
2. アルミナセラミック基板 (12.5×20×0.7mm)  
使用時の許容値。

UPAK



1. ゲート
2. ドレイン
3. ソース
4. ドレイン

## 電 気 的 特 性

(Ta = 25°C)

項 目	記号	Min	Typ	Max	単位	測定条件
ドレイン遮断電流	$I_{DSS}$	—	—	-1	$\mu A$	$V_{DS} = -8V, V_{GS} = 0$
ゲート遮断電流	$I_{GSS}$	—	—	$\pm 5$	$\mu A$	$V_{GS} = \pm 6.5V, V_{DS} = 0$
ゲート・ソース遮断電圧	$V_{GS(off)}$	-0.4	—	-1.4	V	$V_{DS} = -5V, I_D = -100\mu A$
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(on)1}$	—	0.4	0.7	$\Omega$	$V_{GS} = -2.2V, I_D = -0.5A^{*1}$
	$R_{DS(on)2}$	—	0.28	0.35	$\Omega$	$V_{GS} = -4V, I_D = -1A^{*1}$
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	1	2.3	—	S	$V_{DS} = -5V, I_D = -1A^{*1}, \Delta V_{GS} = 0.2V$
入力容量	$C_{iss}$	—	63	—	pF	$V_{DS} = -5V, V_{GS} = 0,$ $f = 1MHz$
出力容量	$C_{oss}$	—	180	—	pF	
帰還容量	$C_{rss}$	—	23	—	pF	
ターンオン時間	$t_{(on)}$	—	590	—	ns	$I_D = -0.2A^{*1}, V_{GS} = 0,$
ターンオフ時間	$t_{(off)}$	—	2350	—	ns	$R_L = 51\Omega, V_{in} = -4V$

注) 1. パルス測定

現品マークは，“NY”です。

